

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-338211

(P2000-338211A)

(43)公開日 平成12年12月8日 (2000.12.8)

(51)Int.Cl.⁷

G 0 1 R 33/09
H 0 1 L 43/08

識別記号

F I

G 0 1 R 33/06
H 0 1 L 43/08

マークコード(参考)

R 2 G 0 1 7
Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平11-148441

(22)出願日 平成11年5月27日 (1999.5.27)

(71)出願人 000237721

富士電気化学株式会社

東京都港区新橋5丁目36番11号

(72)発明者 林 智幸

東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気
化学株式会社内

(72)発明者 鈴木 保敏

東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気
化学株式会社内

(74)代理人 100078961

弁理士 茂見 稔

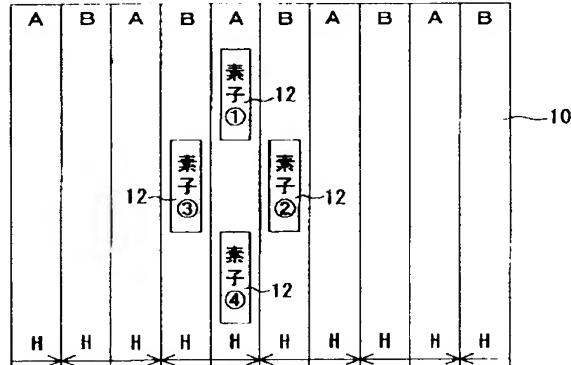
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁気センサ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 4個のスピナブルブ型磁気抵抗素子を同一基板上に配列形成して、構造が複雑化することなくブリッジ結線できるようにする。

【解決手段】 4個のスピナブルブ型磁気抵抗素子が同一基板上で菱形の頂点位置に配列形成されると共に、前記基板上でそれら各磁気抵抗素子間をループ状に接続する導電体層が形成されており、各磁気抵抗素子の境界に応答し難いピン止め磁性層の磁化方向が、対角の位置関係にある磁気抵抗素子同士では平行、隣接する位置関係にある磁気抵抗素子同士では反平行となっている構造である。磁気抵抗素子は、スピナブルブ型GMR素子でもよいし、スピナブルブ型トンネルMR素子でもよい。これらの磁気センサは、ストライブ状に多極着磁した永久磁石板10の上に基板を載せ、磁気抵抗素子12の成膜を行うか、あるいは磁気抵抗素子の熱処理を行うことで製造する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 4個のスピンドル型磁気抵抗素子が単一基板上で菱形の頂点位置に配列形成されると共に、前記基板上でそれら各磁気抵抗素子間をループ状に接続する導電体層が形成されており、前記各磁気抵抗素子の磁界に応答し難いピン止め磁性層の磁化方向か、対角の位置関係にある磁気抵抗素子同士では平行、隣接する位置関係にある磁気抵抗素子同士では反平行となっていることを特徴とする磁気センサ。

【請求項2】 スピンドル型磁気抵抗素子か、外部磁界に対し磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、非磁性金属層と、外部磁界に対し応答し難いピン止め磁性層と、該ピン止め磁性層をピン止めする反強磁性層を積層した構造のスピンドル型GMR素子である請求項1記載の磁気センサ。

【請求項3】 スピンドル型磁気抵抗素子か、外部磁界に対し磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、絶縁層と、外部磁界に対し応答し難いピン止め磁性層と、該ピン止め磁性層をピン止めする反強磁性層を積層した構造のスピンドル型トンネルMR素子である請求項1記載の磁気センサ。

【請求項4】 請求項1乃至3記載の磁気センサを製造する方法において、ストライプ状に多極着磁した永久磁石板の上に基板を載せ、対角の位置関係にある一对の磁気抵抗素子が同一のストライプ状領域の上に位置し、残りの2個の磁気抵抗素子が前記一对の磁気抵抗素子の両側の逆向きに着磁されたストライプ状領域の上にそれぞれ位置するようにし、その上で磁気抵抗素子の成膜を行うことを特徴とする磁気センサの製造方法。

【請求項5】 請求項1乃至3記載の磁気センサを製造する方法において、ストライプ状に多極着磁した永久磁石板の上に基板を載せ、対角の位置関係にある一对の磁気抵抗素子が同一のストライプ状領域の上に位置し、残りの2個の磁気抵抗素子が前記一对の磁気抵抗素子の両側の逆向きに着磁されたストライプ状領域の上にそれぞれ位置するようにし、その上で磁気抵抗素子の熱処理を行うことを特徴とする磁気センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、4個のスピンドル型磁気抵抗素子を単一基板上で菱形の頂点に位置するように配列形成し、それらを導電体層でループ状に接続した構造の磁気センサ及びその製造方法に関するものである。この磁気センサは、例えば地磁気の検出や微小位置決めセンサなどに有用である。

【0002】

【従来の技術】 微小な磁界を検知する超高感度磁気センサとして、Ni/Fe、Co/Fe膜の異方性磁気抵抗効果(AMR)を利用するものがある。この種の磁気センサは、フォトリソグラフィー技術によって基板上に多数個

形成するように、蒸着法あるいはスパッタ法などにより作製される。これらの磁性膜は、温度変化に敏感であるため、ブリッジを組んで差動出力をとるよう構成する。

【0003】 軟磁性膜の異方性の制御方法としては、素子パッケージの形状異方性を利用する方法と、永久磁石による磁界やコイルへの通電による磁界を印加しながら成膜して誘導磁気異方性を付与する方法がある。異方性磁気抵抗効果(AMR)を利用する磁気抵抗素子においては、膜の磁化方向と電流の流れる向きとの相対角度で抵抗が変化するため、零磁界から正負の磁界に対して抵抗は対称に変化する。磁界センサとしては、ブリッジ回路で差動出力を得るよう結線するため、磁気抵抗素子にバイパス磁界を加え、磁界に対する応答を線形にしている。

【0004】 異方性磁気抵抗効果(AMR)は、抵抗変化率($(\Delta R/R)/R$)が2~3%と低く、そこで、より高感度化の要求に対応するためGMR(巨磁気抵抗効果)を利用したスピンドル型GMR素子やスピントンネル現象を利用したスピンドル型トンネルMR素子を用いる磁気センサが提案されている。

【0005】 スピンドル型GMR素子は、外部磁界に対し磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、非磁性金属層と、外部磁界に対し応答し難いピン止め磁性層を積層した構造を有しており、2つの磁性層の磁化の向きの相対角度に依存して電気抵抗が変化する現象を利用している。このようなスピンドル型GMR素子は、磁界に対する線形性が優れ、且つ抵抗変化率が5~10%と高い特性をもつ。

【0006】 スピンドル型トンネルMR素子は、外部磁界に対し磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、絶縁層と、外部磁界に対し応答し難いピン止め磁性層を積層した構造を有しており、2つの磁性層間に電圧を印加し、電子をトンネリングさせたときの2つの磁性層の磁化の向きの相対角度により、電子のトンネル確率が変化する現象を利用している。外部磁界に対する抵抗変化率の変化を大きくするため、強磁性層に隣接して反強磁性層(FeMn、NiMn)を積層する構成が提案されている(特開平9-106514号公報参照)。また、Ni/Fe/Co/絶縁層(A1/A2/O_x)_n/Co/Ni/Fe/FeMnの積層構造において抵抗変化率が10%以上得られることが報告されている(「磁化固定層をもつ強磁性トネル接合の磁気抵抗効果」佐藤重雄、小林和雄、日本応用磁気学会誌21,489-492(1997)参照)。

【0007】 これらのスピンドル型磁気抵抗素子においては、ピン止め磁性層の磁化方向で磁界に対する線形動作方向を変化させることができる。このピン止め磁性層は反強磁性材料(FeMn、NiMn、IrMn、P

dPtMn等)を隣接して積層することで磁化方向を固定する。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】4個のスピンドル型磁気抵抗素子をプリッジを組み、磁界に対して差動出力を得るには、磁界に対して応答しないビン止め磁性層の磁化の向きを隣り合う素子同士で+180度変えなければならない。ビン止め磁性層の磁化方向は、その上に成膜する反強磁性膜で決定される。その磁化方向は、成膜中の基板表面上に印加する磁界の向きによって規定される。反強磁性膜のオール温度付近からの磁界中熱処理における磁界方向によって規定される。

【0009】成膜時や熱処理中の磁界は永久磁石や電磁石によって与えられ、基板上には一方向の均一磁界が印加される。そのためビン止め磁性層の磁化の向きを+180度変えたスピンドル型磁気抵抗素子を同一基板上に混在させることができない。そこで、プリッジを組んだ磁気センサは、通常、個々のスピンドル型磁気抵抗素子を基板から取り出しリード線などで配線することで組み立てことになる。そうすると、配線などの工程が増え、小型化の妨げになるし、パッケージングの面でも難しくなる。

【0010】このような問題を解決する技術として、同一基板上でプリッジを組んだ磁気センサ上に、絶縁体層を介して導電体層を形成し、この導電体層に通電して磁界を発生させることによりビン止め磁性層の磁化の向きを+180度変える方法が提案されている(特開平8-226960号公報参照)。しかし、この方法は、構成が複雑になる問題がある。

【0011】本発明の目的は、4個のスピンドル型磁気抵抗素子を同一基板上に配列形成してプリッジを組んだ磁気センサ及びその製造方法を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明は、4個のスピンドル型磁気抵抗素子が同一基板上で菱形の頂点位置に配列形成されると共に、前記基板上でそれら各磁気抵抗素子間をリード状に接続する導電体層が形成されており、前記各磁気抵抗素子の磁界に応答し難いビン止め磁性層の磁化方向が、対角の位置関係にある磁気抵抗素子同士では平行・隣接する位置関係にある磁気抵抗素子同士では反平行となっている磁気センサである。4個のスピンドル型磁気抵抗素子を同一基板上で菱形の頂点位置に配列形成することにより、ビン止め磁性層の磁化方向を制御すると共に、基板上でそれら各磁気抵抗素子間を導電体層で接続することが可能となる。

【0013】ここでスピンドル型磁気抵抗素子は、外部磁界に対して磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、非磁性金属層と、外部磁界に対して応答し難いビン止め磁性層と、該ビン止め磁性層をビン止めする反強磁性層を積層した構造のスピンドル型トランジタルMR素子である。

は外部磁界に対し磁化の向きを自由に変えるフリー磁性層と、絶縁層と、外部磁界に対し応答し難いビン止め磁性層と、該ビン止め磁性層をビン止めする反強磁性層を積層した構造のスピンドル型トランジタルMR素子である。

【0014】このような磁気センサは、ビン止め磁性層の上に成膜する反強磁性層がT₁MnやT₂Mnのような不規則格子の場合には、ストライプ状に多極着磁した永久磁石板の上に基板を載せ、対角の位置関係にある一对の磁気抵抗素子が同一のストライプ状領域の上に位置し、残りの2個の磁気抵抗素子が前記一对の磁気抵抗素子の両側の逆向きに着磁されたストライプ状領域の上にそれぞれ位置するようにし、その上で磁気抵抗素子の成膜を行うことで製造する。

【0015】あるいは、ビン止め磁性層の上に成膜する反強磁性層がT₁MnやT₂dPtMn等の規則格子の場合には、ストライプ状に多極着磁した永久磁石板の上に基板を載せ、対角の位置関係にある一对の磁気抵抗素子が同一のストライプ状領域の上に位置し、残りの2個の磁気抵抗素子が前記一对の磁気抵抗素子の両側の逆向きに着磁されたストライプ状領域の上にそれぞれ位置するようにし、その上で磁気抵抗素子の熱処理を行うことにより製造する。

【0016】

【発明の実施の形態】スピンドル型磁気抵抗素子のビン止め磁性層・反強磁性層・成膜の際、あるいは熱処理の際、各磁気抵抗素子の形成に対応してストライプ状に微小着磁した永久磁石板を用いる。図1に示すように、永久磁石板10は、着磁方向が+180度程なり同幅の細長いA領域とB領域(ここではA領域の真上には団面右向きの磁界印記、B領域の真上には団面左向きの磁界印記が発生している)が交互に形成されたものである。本発明で用いる永久磁石板は、一枚の永久磁石平板を上記のように着磁したものでもよいし、端方向に着磁した細長い永久磁石を多数配列した構成てもよい。図2に示すように、4個の磁気抵抗素子12(素子①～④)でプリッジを組むとき、前記の永久磁石板10上に基板を載せ、図3に示すように、例えば素子①と素子④がA領域の真上に、素子②と素子③がそれに隣接するB領域の真上に位置するように、即ち各素子が菱形の頂点位置にくるように、基板にハサミできし成膜するか、あるいはそのような状態で熱処理を行う。

【0017】すると、素子①と④は図4(a)の破線(b)で示すような抵抗変化を呈し、素子②と③は図4(b)の破線(b)で示すような抵抗変化を呈することになる。そこで、これら各素子間をリード状に導電体膜で結線する。これにより、同一基板上に4個のスピンドル型磁気抵抗素子を配列形成し且つ導電体膜でプリッジ結線することが可能となる。図5はスピンドル型GMR素子を用いた配置例、図6はスピンドル型トランジタルMR素子を

用いた配置例である。なお図13は、導電体膜を示している。

【0018】スリーハルフ型GMR素子の基本膜構成の例を図7に示す。これは、基板20上に、下地層22 (Ta, Zr膜)、フリーマグニッシュ層24 (NiFe膜又はCoFe、Co、CoFeB膜)、非磁性金属層26 (Co膜)、固定層28 (CoFe、Co、CoFeB膜又はNiFe膜からなるビン止め磁性層30) 及びFeMn、IrMn、PtMn膜の反強磁性層32)、保護層34 (Ta膜)をその順序で積層した構成である。これらの層は全てほぼ同じ矩形形状であり、同じ向きに積層されている。

【0019】また、スピンドル型トニカルMR素子の基本膜構成の例を図8に示す。これは、基板40上に、下地層42 (Ta, Zr膜)、フリーマグニッシュ層44 (NiFe膜又はCoFe、Co、CoFeB膜)、絶縁層46 (Al, O_x膜)、固定層48 (CoFe、Co、CoFeB膜又はNiFe膜からなるビン止め磁性層50)、及びFeMn、IrMn、PtMn膜の反強磁性層52)、保護層54 (Ta膜)を積層した構成である。例えば、横向き細長状で中央が突き出たフリーマグニッシュ層44、円形の絶縁層46、縦向き細長状で中央が突き出た固定層48が積層されている。

【0020】

【実施例】(実施例1) S上基板上に絶縁層S10₁を2000Å形成する。次に、各素子を菱形配置するためメタルマスクを取り付け、真空チャンバ内にセットする。そして、各素子の長手方向に同一方向に均一磁界が加わるように永久磁石板を配置する。その状態で、下地層(Ta膜)、フリーマグニッシュ層(NiFe膜)、非磁性金属層(Co膜)を順次成膜する。各膜の厚さは、下地層Ta: 50Å、フリーマグニッシュ層NiFe: 120Å、非磁性金属層Co: 30Åである。

【0021】次に基板をストライプ着磁した永久磁石上に配置して、真空チャンバ内にセットする。ここでは、手めストライプ着磁した永久磁石板を真空チャンバ内に設置しておき、その上に基板を載せる方法で行った。この状態でビン止め磁性層(NiFe膜)、反強磁性層(FeMn膜)、保護層(Ta膜)を順次成膜する。各膜の厚さは、ビン止め磁性層NiFe: 30Å、反強磁性層FeMn: 90Å、保護層Ta: 50Åである。そして、これらの素子間を接続するようにメタルマスクを施し、導電体層(Ag膜)を形成する。

【0022】この試料の電圧印加端子(図1の端子1及び2)に電圧V(100mV)を印加して、出力電圧端子(図1の端子3及び4)間に磁界に対するブリッジ出力電圧を測定した。その結果、図9に示すように、印加磁界に対して出力電圧が変化し、磁界センサとして機能していることが確認できた。

【0023】(実施例1-2) S上基板上に絶縁層S10₁

O_xを2000Å形成する。次に、各素子を菱形配置するためメタルマスクを取り付け、真空チャンバ内にセットする。そして、各素子の長手方向に均一磁界が加わるように永久磁石板を配置する。その状態で、下地層(Ta膜)、フリーマグニッシュ層(NiFe膜)、非磁性金属層(Co膜)を順次成膜する。各膜の厚さは、下地層Ta: 50Å、フリーマグニッシュ層NiFe: 120Å、非磁性金属層Co: 30Åである。

【0024】次に、基板の磁界が90度異なるように向きを変えて真空チャンバ内にセットする。ここでは、手め90度回転させた永久磁石板を真空チャンバ内に設置しておき、その上に基板を載せる方法で行った。この状態でビン止め磁性層(NiFe膜)、反強磁性層(FeMn膜)、保護層(Ta膜)を順次成膜する。各膜の厚さは、ビン止め磁性層NiFe: 30Å、反強磁性層FeMn: 90Å、保護層Ta: 50Åである。そして、これらの素子間を接続するようにメタルマスクを施し、導電体層(Ag膜)を形成する。

【0025】反強磁性層でビン止め磁性層を固定している場合は、反強磁性層のマルチ温度付近の温度から磁場中冷却を施すことにより、磁界方向にビン止め磁性層を固定できる。そこで、上記のように作製した試料を、真空中200°Cで約1時間熱処理し徐冷する。磁界は、上から右端に着磁した永久磁石上に基板を配置することで印加する。永久磁石としては、2.0Tにおいても磁界を発生できる1.7系SmCoの磁石を用いた。

【0026】この試料の電圧印加端子に電圧V(100mV)を印加し、出力電圧端子間に磁界に対するブリッジ出力電圧を測定した。その結果、図9に示すのと同様、印加磁界に対して出力電圧が変化し、磁界センサとして機能していることが確認できた。

【0027】(実施例2) S上基板上に絶縁層S10₁を2000Å形成する。次に各素子を菱形配置するためメタルマスクを取り付け、真空チャンバ内にセットする。そして、各素子の長手方向に垂直に均一磁界が加わるように永久磁石板を配置する。その状態で下地層(Ta膜)、フリーマグニッシュ層(NiFe膜/CoFe膜)を順次成膜する。各膜の厚さは、下地層Ta: 50Å、フリーマグニッシュ層NiFe: 120Å、CoFe: 30Åである。次に絶縁層を成膜する。基板を一旦大気中に取り出し、絶縁層用のマスクに切り替え、真空チャンバ内にセットする。このとき磁界印加用の永久磁石は無くてもよい。ここでAl金属膜を13Å成膜する。そして大気中に取り出し、室温、大気中で240時間保持し、Al膜を酸化させてAl₂O₃膜にする。ガラスマ醇化や高温醇化してもよい。

【0028】その後、基板をストライプ着磁した永久磁石上に配置して、真空チャンバ内にセットする。ここでは、手めストライプ着磁した永久磁石板を真空チャンバ内に設置しておき、その上に基板を載せる方法で行

た。この状態でビン止め磁性層 (CoFe膜+NiFe膜) / 反強磁性層 (FeMn膜) / 保護層 (Ta膜) を順次成膜する。各膜の厚さは、ビン止め磁性層CoFe: 30Å、NiFe: 30Å、反強磁性層FeMn: 90Å、保護層Ta: 50Åである。そして、これらの素子間を接続するようにメタルマスクを施し、導電体層 (Ag膜) を形成する。

【0029】この試料の電圧印加端子に電圧V (100mV) を印加し、磁界に対してプリッジ出力電圧を測定した。その結果、図10に示すように、印加磁界に対して出力電圧が変化し、磁界センサとして機能していることが確認できた。

【0030】(実施例2-2) S+基板上に絶縁層SiO₂を2000Å形成する。次に各素子を菱形配置するためメタルマスクを取り付け、真空チャンバ内にセットする。そして、各素子の長手方向に垂直に均一磁界が加わるように永久磁石板を配置する。その状態で下地層 (Ta膜) / フリー磁性層 (NiFe膜+CoFe膜) を順次成膜する。各膜の厚さは、下地層Ta: 50Å、フリー磁性層NiFe: 120Å、CoFe: 30Åである。次に絶縁層を成膜する。基板を一旦大気中に取り出し、絶縁層用のマスクに切り替え、真空チャンバ内にセットする。このとき磁界印加用の永久磁石は無くてもよい。ここでAl金属膜を13Å成膜する。そして大気中に取り出し、室温、大気中で240時間保持し、Al膜を酸化させてAl₂O₃膜にする。

【0031】その後、基板への磁界が90度異なるよう逆向きを変えて真空チャンバ内にセットする。ここで一組め90度回転させた永久磁石板を真空チャンバ内に設置しておき、その上に基板を載せる方法で行った。この状態でビン止め磁性層 (CoFe膜+NiFe膜) / 反強磁性層 (FeMn膜) / 保護層 (Ta膜) を順次成膜する。各膜の厚さは、ビン止め磁性層CoFe: 30Å、NiFe: 30Å、反強磁性層FeMn: 90Å、保護層Ta: 50Åである。そして、これらの素子間を接続するようにメタルマスクを施し、導電体層 (Ag膜) を形成する。

【0032】反強磁性層でビン止め磁性層を固定している場合は、反強磁性層のキール温度付近の温度から磁場中冷却を施すことにより、磁界方向にビン止め磁性層を固定できる。そこで、上記のように作製した試料を、真空中200°Cで約1時間熱処理し徐冷する。磁界は、ストライプ状に着磁した永久磁石上に基板を配置することで印加する。永久磁石としては、200°Cにおいても磁界を発生できる2-17%SmCo磁石を用いた。

【0033】この試料の電圧印加端子に電圧V (100mV) を印加し、磁界に対してプリッジ出力電圧を測定した。その結果、図10に示すと同様、印加磁界に対して出力電圧が変化し、磁界センサとして機能していることが確認できた。

【0034】上記の各実施例においては、素子形成にメタルマスクを用いているが、フォトリソグラフィー技術により作製しても何ら問題はない。実際には、同一基板上に多数の磁気センサを一括して形成し、個々に切り出して製品とする。

【0035】

【発明の効果】本発明は上記のように構成した磁気センサであるから、構造が複雑化することなく同一基板上に4個のスピンドル型磁気抵抗素子を一括して配列形成してプリッジを組むことができ、小型化に適し、磁界応答性を高めてくる。

【0036】また本発明によれば、同一基板上に4個のスピンドル型磁気抵抗素子を配列形成してプリッジを組んだ小型の磁気センサを、効率よく安価に製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で用いるストライプ状に着磁した永久磁石板の説明図。

【図2】磁気センサにおけるプリッジ構成の説明図。

【図3】本発明におけるストライプ状に着磁した永久磁石板と各スピンドル型磁気抵抗素子の位置関係を示す説明図。

【図4】各スピンドル型磁気抵抗素子の外部磁界 抵抗値の特性説明図。

【図5】本発明に係るスピンドル型GMR素子を用いた磁気センサの一例を示す配置接続説明図。

【図6】本発明に係るスピンドル型トンネルMR素子を用いた磁気センサの一例を示す配置接続説明図。

【図7】スピンドル型GMR素子の積層構造の一例を示す説明図。

【図8】スピンドル型トンネルMR素子の積層構造の一例を示す説明図。

【図9】本発明に係るスピンドル型GMR素子を用いた磁気センサの出力特性の一例を示す説明図。

【図10】本発明に係るスピンドル型トンネルMR素子を用いた磁気センサの出力特性の一例を示す説明図。

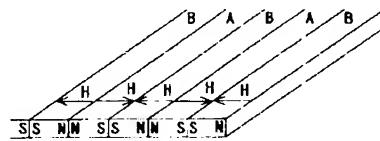
【符号の説明】

1-1 永久磁石板

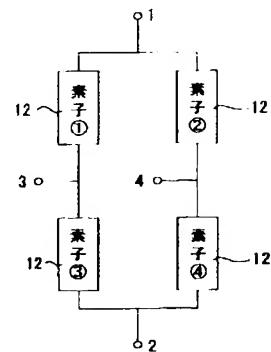
1-2 スピンドル型磁気抵抗素子

1-4 導電体層

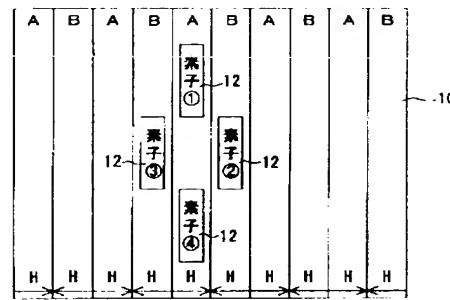
【図1】



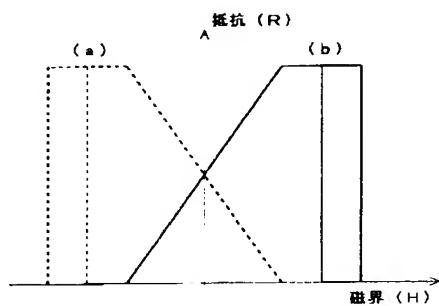
【図2】



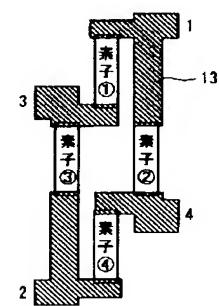
【図3】



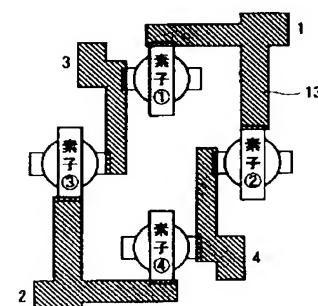
【図4】



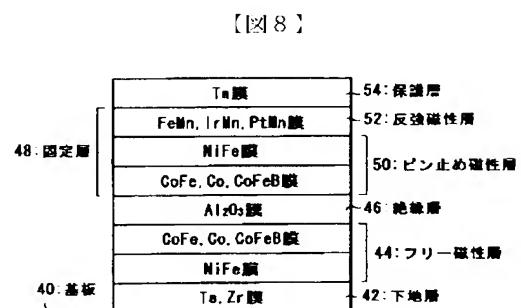
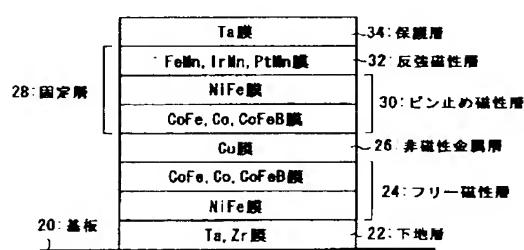
【図5】



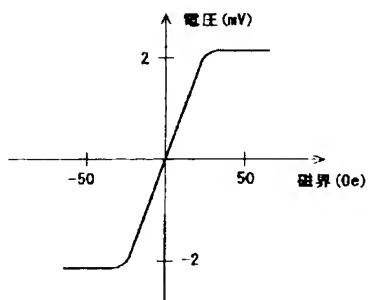
【図6】



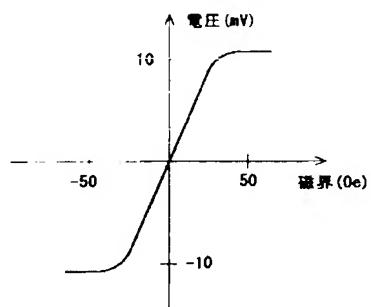
【図7】



【図8】



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 定行 勝
東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気
化学株式会社内

(72)発明者 中野 廣文
東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気
化学株式会社内
F ターム(参考) 2G017 AD55 AD62 AD63 AD65

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-338211

(43)Date of publication of application : 08.12.2000

(51)Int.CI.

G01R 33/09
H01L 43/08

(21)Application number : 11-148441

(71)Applicant : FUJI ELELCROCHEM CO LTD

(22)Date of filing : 27.05.1999

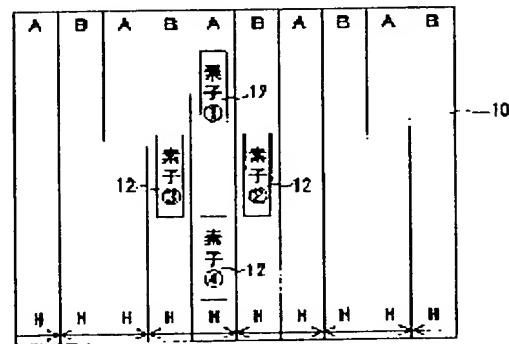
(72)Inventor : HAYASHI TOMOYUKI
SUZUKI YASUTOSHI
SADAYUKI MASARU
NAKANO HIROFUMI

(54) MAGNETIC SENSOR AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit bridge connection without complicating structure by aligning and forming four spin valve type magneto resistance elements on the same substrate.

SOLUTION: In this magnetic sensor, four spin valve type magneto resistance elements are aligned and formed at vertex positions of a rhombus on a single substrate, and a conductor layer connecting the elements in a loop type on the substrate is formed. As to the magnetization direction of a pinned magnetic layer of each element which is hard to respond to a magnetic field, elements in the diagonal position relation have a parallel relation, and elements in the adjacent position relation have an reverse parallel relation. The element may be a spin valve type GMR element or a spin valve type tunnel MR element. The magnetic sensor is manufactured by a method wherein a substrate is mounted on a permanent magnet plate 10 subjected to multipole magnetization in a stripe type and a film of the element 12 is formed or the element 12 is heat-treated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998,2000 Japan Patent Office